

## جبران‌سازی اثرات اختلال سطح آتن بازتابنده با استفاده از بازتابنده فرعی شکل داده شده

سید ابوالفضل حدادی<sup>۱</sup>، ایاز قربانی<sup>۲\*</sup>

۱- دانشجوی دکتری، ۲- دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر  
(دریافت: ۹۵/۰۸/۰۲؛ پذیرش: ۹۵/۱۱/۱۲)

### چکیده

ظاهرشدن اختلال بر سطح بازتابنده اصلی سبب تغییر الگوی تشعشعی در آتن‌های بازتابنده شده و ویژگی‌های تشعشعی این آتن را به خصوص در فرکانس‌های بالا تخریب می‌کند. روش‌های متفاوتی برای جبران‌سازی اثرات نامطلوب اختلال سطح بازتابنده اصلی وجود دارد. در این مقاله، نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان با استفاده از شکل‌دهی سطح بازتابنده از اقدام به جبران‌سازی این اثرات نمود. بر مبنای ریاضیات وردی‌شی می‌توان الگوی تشعشعی آتن بازتابنده را خطی‌سازی و به صورت ماتریسی بازنویسی کرد. با استفاده از روش تفکیک مقادیر ویژه می‌توان اقدام به حل مسئله معکوس نموده و نشان داده می‌شود که برای یک ساختار دویازتابنده‌ای، روش ارائه شده با دقت مناسبی قادر به طراحی بازتابنده فرعی مطلوب است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که اگر دامنه نشان می‌باشد که بازتابنده اصلی کمتر از یک‌چهارم طول موج باشد، الگوریتم ارائه شده با دقت و سرعت قادر به طراحی بازتابنده فرعی مورد نظر است.

### واژگان کلیدی

آتن بازتابنده، روش نور فیزیکی، اختلالات سطح، جبران‌سازی، بازتابنده فرعی شکل داده شده.

لبه‌ها، نظریه هندسی پراش (GTD) جهت اصلاح روش GO و فیزیکی پراش (PTD) برای اصلاح روش PO ارائه شده‌اند [۲].

چنان‌چه هدف از تحلیل، تعیین الگوی تشعشعی در محدوده پرتو اصلی و چند گلبرگ کناری اول باشد روش PO دارای دقت و سادگی در پیاده‌سازی است [۴]. این در حالی است که روش‌های GO/GTD در محل پرتو اصلی قادر به تعیین جهت‌مندی نیستند [۵].

از نظر تئوری، آتن بازتابنده دارای پهنانی باند نامحدود است. آن‌چه در عمل سبب محدودشدن پهنانی باند می‌شود، اختلال سطح روی بازتابنده است که از هم فاژشدن میدان‌های بازتابش جلوگیری می‌کند. این پدیده به خصوص در فرکانس‌های بالاتر با کاهش طول موج و بزرگ‌شدن اثرات اختلال سطح، مشهودتر است [۲]. این نوع اختلال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند [۶]: اختلال تصادفی و اختلال منظم.

اختلال تصادفی ناشی از پدیده‌های تصادفی در فرآیندهای ساخت و نصب بازتابنده هستند [۷]. ماشین‌های تولیدکننده سطوح بازتابنده دقیقی محدود دارند. همچنین نصب این سطوح نیز با ادواتی صورت می‌پذیرد که دارای دقت محدودی هستند. تمامی این موارد به صورت تصادفی ظاهر می‌شوند و تفکیک حد اثرگذاری آن‌ها چندان میسر نیست. در هر حال، ترکیب این اثرات موجب تغییرات اغلب نامطلوبی در رفتار الگوی تشعشعی آتن می‌شوند.

### ۱- مقدمه

اگرچه که ویژگی‌های آتن بازتابنده توسط ایزاك نیوتون در قرن ۱۶ میلادی کشف شده و در تلسکوپ‌های بازتابی از آن استفاده شد، اما این آتن تا جنگ جهانی دوم، جز در اخترشناسی، چندان مورد توجه قرار نگرفت [۱]. از آن پس، کاربردهای متعدد راداری، ماهواره‌ای و سنجشی برای این آتن تعریف شده و مورد استفاده قرار گرفته است [۲]. به دلیل بهره زیاد، از این آتن در مخابرات ماهواره‌ای، زمینی، عمق فضای عکس‌برداری‌های راداری استفاده می‌شود [۳]. مزیت اصلی این آتن، ارائه بهره بالا پهنانی باند وسیع و هزینه نسبتاً کم است. آتن بازتابنده اصلی سهمی از متدوال ترین انواع این آتن است. این آتن‌ها می‌توانند قطری تا ۱۰۰۰ برابر طول موج داشته باشند و محدوده فرکانسی آن‌ها می‌تواند از ۲۰۰ MHz تا ۲۰۰ GHz باشد [۱].

تکنیک‌های متفاوتی برای تحلیل آتن‌های بازتابنده وجود دارد. به دلیل بزرگ‌بودن ساختارهای بازتابنده نسبت به طول موج، استفاده از روش‌هایی چون ممان (MoM) و المان محدود (FEM) چندان متدوال نیست. در عوض، روش‌های مجانی با بهره‌گیری از مفهوم ردگیری اشعه یا جریان القایی در این‌گونه ساختارها بسیار کارآمد هستند. روش نور هندسی (GO) برمبنای ردگیری اشعه و روش نور فیزیکی (PO) برمبنای جریان القایی از معروف‌ترین روش‌های مجانی هستند. برای دخیل کردن پراش

مکانیکی سطح به صورت اکتیو [۳۴-۳۵] که از این روش به خصوص در رادیوتلسکوپ‌هایی که بازتابنده آن‌ها به صورت پنل‌های مجاور هم است، استفاده می‌شود [۳۶-۳۷]. این روش اغلب نیازمند صرف هزینه بالایی است و جز در مورد سازه‌های عظیم توجیه ندارد.

۲- استفاده از آرایه تغذیه که [۳۸-۴۱] در این روش میدان تابشی به سطح اختلال یافته به گونه‌ای تغییر می‌یابد که انحراف فاز دهانه‌ای ناشی از جابه‌جایی سطح، توسط میدان تغذیه جرمان شود. طراحی شبکه و ساخت آن‌ها موجب افزایش هزینه و وزن و پیچیدگی سامانه خواهد شد.

۳- استفاده از رفکتور فرعی شکل یافته [۴۲-۴۵] که موضوع مورد بحث در این مقاله است، نیز روشی متداول است. در این حالت اختلال سطح بازتابنده اصلی با ایجاد برآمدگی و فرورفتگی و به اصطلاح شکل‌دهی بازتابنده فرعی جرمان‌سازی می‌شود. این روش از نظر پیاده‌سازی ساده‌تر از دو روش دیگر است به خصوص در مواقعي که هزینه‌های مالی جز فاکتورهای طراحی باشد. البته نقطه ضعف این راه کار آن است که در این روش اختلال سطح بازتابنده اصلی یکبار برای همیشه بازتابنده فرعی جرمان می‌شوند و در صورت بروز اختلال جدید، این اختلال قابل جرمان‌سازی نیستند. البته بازتابنده فرعی در برخی موارد به صورت آرایه بازتابی تخت و سطوح تخت شکل‌پذیر نیز گزارش شده که این حالت مورد بحث ما نخواهد بود.

این مقاله در صدد آن است تا برای یک آنتن دو بازتابنده‌ای، سطح بازتابنده فرعی را به گونه‌ای شکل دهیم که میدان تشبعی از بازتابنده اصلی اختلال یافته تا حد ممکن نزدیک به میدان تشبعی آنتن بدون اختلال باشد. یک راه حل ساده، استفاده از تقریب اشعه نور هندسی است و به این ترتیب مسیر اشعه‌های مختلف از تغذیه به بازتابنده فرعی و از بازتابنده فرعی به بازتابنده اصلی یکسان می‌شود. این تقریب، دچار عدم دقت زیاد بدليل در نظر نگرفتن پدیده‌های پراش است و از این‌رو در این مقاله مورد توجه قرار نگرفته و در عوض از تقریب نور هندسی استفاده خواهد شد.

در [۲۵] تعداد زیادی پارامتر برای توصیف سطح رفکتور فرعی و اصلی استوانه‌ای (ونه سهمی) استفاده شده و با پیاده‌سازی یک الگوریتم بهینه‌سازی، پارامترهای توصیفی سطح بازتابنده فرعی به دست می‌آیند. چنین روشنی نیازمند تعداد تکرارهای زیاد است و در بازتابنده‌های بزرگ چندان کارآمد نخواهد بود. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با داشتن یک رابطه خطی بین تغییرات میدان‌های تشبعی و تابع اختلال سطح، مسئله طراحی بازتابنده فرعی جرمان‌ساز با سرعت قابل حل است.

نویسنده‌گان مقاله حاضر در مقاله‌ای جداگانه اقدام به خطی‌سازی الگوی تشبعی آنتن بازتابنده اختلال یافته نموده‌اند [۴۶]. این فرمول‌بندی قادر است تا در حضور اختلالی با دامنه کمتر از یک‌چهارم طول موج با دقیقی بسیار بالا الگوی تشبعی

در [۷] یک رابطه آماری مفید برای افت جهت‌مندی آنتن بازتابنده ارائه شده است. سپس در [۸] توضیح داده شد که فرمول مذکور میزان افت بهره را بیشتر از مقدار واقعی تخمين می‌زند و بر این مبنای مدلی برای اصلاح این رابطه ارائه شد. البته کارهای دیگری نیز برای تحلیل اثرات اختلال تصادفی بر سطح پلاریزاسیون متعامد [۹-۱۰]، سطح گلبرگ‌های جانبی [۱۱-۱۳] و شکل الگوی تشبعی [۱۴-۱۵] نیز صورت پذیرفته است. در تمامی این کارها از تقریب نورهندسی استفاده شده است.

اختلال منظم ناشی از پدیده‌های است که قابل اندازه‌گیری و اجتناب هستند. تغییرات دمایی منجر به تغییر سطح بازتابنده می‌شوند. همچین گرانش زمین نیز باعث ایجاد اختلال بر سطح آنتن می‌شود. لرزش‌ها و تنش‌های ناشی از فرآیند جهت‌گیری نیز به صورت دینامیک سطح را تغییر می‌دهد. در این حالت، تحلیل‌های آماری کارآمد نیست و باید برای هر شکلی از اختلال، تحلیل جداگانه داشت.

برای رده‌ای از اختلال‌های منظم متداول در برخی مقالات تلاش‌هایی برای شناسایی اثرات اختلالی بر بهره محوری، سطح گلبرگ‌های کناری، سطح پلاریزاسیون مقاطع و شکل الگوی تشبعی صورت پذیرفته است [۲۴، ۴]. همچنین، اختلال‌های متناوب باعث بروز گلبرگ‌های گریتینگ می‌شود که در [۱۷-۱۸، ۲۵] مورد توجه قرار گرفته است. در تمامی این کارها، کلاسی از اختلال در نظر گرفته شده و نحوه تغییرات پارامترهای تشبعی رصد شده است.

برای تعیین اختلال سطح بازتابنده در عمل از روش فوتوگرامتری [۲۶-۲۷] استفاده می‌شود. در این روش نشان‌گرهایی بر سطح بازتابنده نصب می‌شود و با دوربینی مخصوص موقعیت این نشان‌گرهای تعیین می‌شود. هزینه تامین و نگهداری تجهیزات در این روش، آنرا برای بازتابنده‌های عظیم مناسب می‌سازد.

روش دیگر، انجام هولوگرافی [۲۸-۳۰] است. در این روش دامنه و فاز میدان دور آنتن در محدوده زاویه‌ای نسبتاً وسیع و در تعداد نقاط زیادی اندازه‌گیری شده و از روی تبدیل فوریه معکوس آن، میدان‌های دهانه‌ای آنتن بازتابنده به دست می‌آیند. با داشتن فاز نسبی میدان‌های دهانه‌ای می‌توان اختلال سطح را ارزیابی نمود. انجام هولوگرافی اغلب وقت‌گیر است و برای اختلال‌های متغیر ممکن است در زمان هولوگرافی شاهد تغییر سطح باشیم [۳۱-۳۲].

در عمل اختلال سطح اجتناب‌ناپذیر است و گاهی اثرات این اختلال آنقدر زیاد است که نیاز به مهار این اثرات مخرب داریم. راه کارهای متفاوتی برای جرمان‌سازی اثرات اختلال سطح بازتابنده داریم. از این میان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد [۳۳]:

۱- قراردادن محرك‌های مکانیکی پشت بازتابنده و اصلاح

$\{x_f, y_f, z_f\}$  بیان شده‌اند. همچنین یک دستگاه مختصات اصلی به صورت  $\{x, y, z\}$  در نظر گرفته شده است که نتایج نهایی مسئله و میدان‌های تشعشعی نهایی در آن بیان می‌شوند. بعلاوه از این دستگاه مختصات به عنوان دستگاه مختصات واسط در تبدیل مختصات بین اجزا نیز استفاده می‌شود.

یک رهیافت بسیار قوی در تحلیل تشعشع از بازتابنده شامل تخمین جریان‌های روی سطح بازتابنده و تبدیل این جریان‌ها به میدان‌های دور با استفاده از قوانین ماکسول است. یک تقریب مناسب آن است که فرض کنیم در هر نقطه از بازتابنده جریان القایی به‌گونه‌ای است که گویی آن نقطه بخشی از یک هادی صفحه‌ای بی‌نهایت است. این تقریب را تقریب نور فیزیکی می‌نامند [۲].

در تقریب نور فیزیکی جریان سطحی روی نقاط سطح بازتابنده

$$\bar{J}^{P0} = 2\hat{u}_N \times \bar{H}^{inc} \quad (1)$$

تقریب زده می‌شود که در آن  $\hat{u}$  بردار نرمال یکه سطح بازتابنده است که به سمت آنتن تغذیه نشانه می‌رود. بردار  $\bar{H}^{inc}$  میدان مغناطیسی تشعشعی تابش یافته توسط آنتن تغذیه است. با داشتن جریان، میدان دور تشعشعی از بازتابنده با انتگرال‌های تشعشعی قابل تعیین است.

طبق تقریب نور فیزیکیتابع تشعشعی به صورت زیر است:

$$\bar{G}(\theta, \phi) = \frac{\eta}{jk\lambda} \hat{u}_N \times \left[ \left[ \int_{\Sigma} \bar{J}^{P0} e^{jk\vec{R} \cdot \hat{u}_r} d\Sigma \right] \times \hat{u}_N \right], \quad (2)$$

که در آن،  $\lambda$  طول موج،  $\eta$  امپدانس فضای آزاد و  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  عدد موج است.

در رابطه (۲)،  $\bar{J}$  بردار موقعیت نقاط بر روی سطح بازتابنده بوده و  $\hat{u}$  بردار نرمال در راستای نقطه مشاهده در میدان دور است که به صورت زیر قابل ارزیابی است:

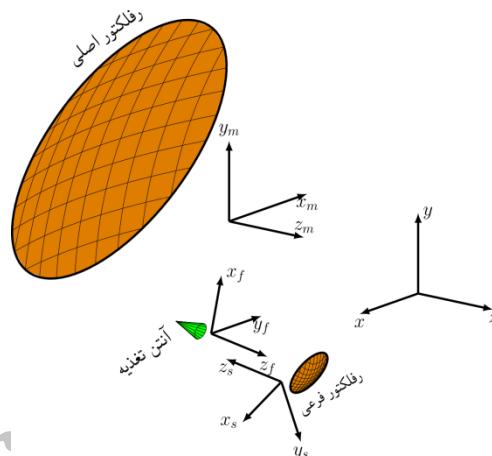
$$\hat{u}_r = \sin \theta \cos \phi \hat{u}_x + \sin \theta \sin \phi \hat{u}_y + \cos \theta \hat{u}_z \quad (3)$$

چنانچه قصد محاسبه میدان تشعشعی در میدان نزدیک را داشته باشیم، می‌توان از فرمول‌بندی (۴) استفاده نمود.

$$\begin{aligned} \bar{E}(r, \theta, \phi) = -jk\eta & \iint_{\Sigma} \left[ \frac{e^{-jk|\vec{R}|}}{4\pi|\vec{R}|} \left( 1 + \frac{1}{jk|\vec{R}|} \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{1}{(jk|\vec{R}|)^2} \right) \bar{J}^{P0} \right. \\ & \left. - \left( 1 + \frac{3}{jk|\vec{R}|} \right. \right. \\ & \left. \left. + \frac{3}{(jk|\vec{R}|)^2} \right) (\bar{J}^{P0} \cdot \hat{u}_R) \hat{u}_R \right] d\Sigma, \end{aligned} \quad (4)$$

که در آن،  $\bar{R} = \bar{r} - \bar{R}$  بوده و میدان مغناطیسی نیز از قوانین ماکسول قابل تعیین است.

اختلال یافته را تعیین نماید. در این مقاله، این فرمول‌بندی به صورت ماتریسی بازنویسی شده و حالت معکوس آن برای یافتن اختلال سطح حل می‌شود. سرعت حل مسئله در مقاله حاضر بسیار بالا خواهد بود. این رهیافت قابل استفاده برای هر نوع آنتن بازتابنده، ساده‌تر از نظر پیاده‌سازی و دارای سرعت بالاتر است.



شکل (۱). اجزای مسئله در تحلیل آنتن‌های بازتابنده شامل آنتن تغذیه، بازتابنده فرعی و آنتن تغذیه و دستگاه‌های مختصات مرتبط با هر یک.

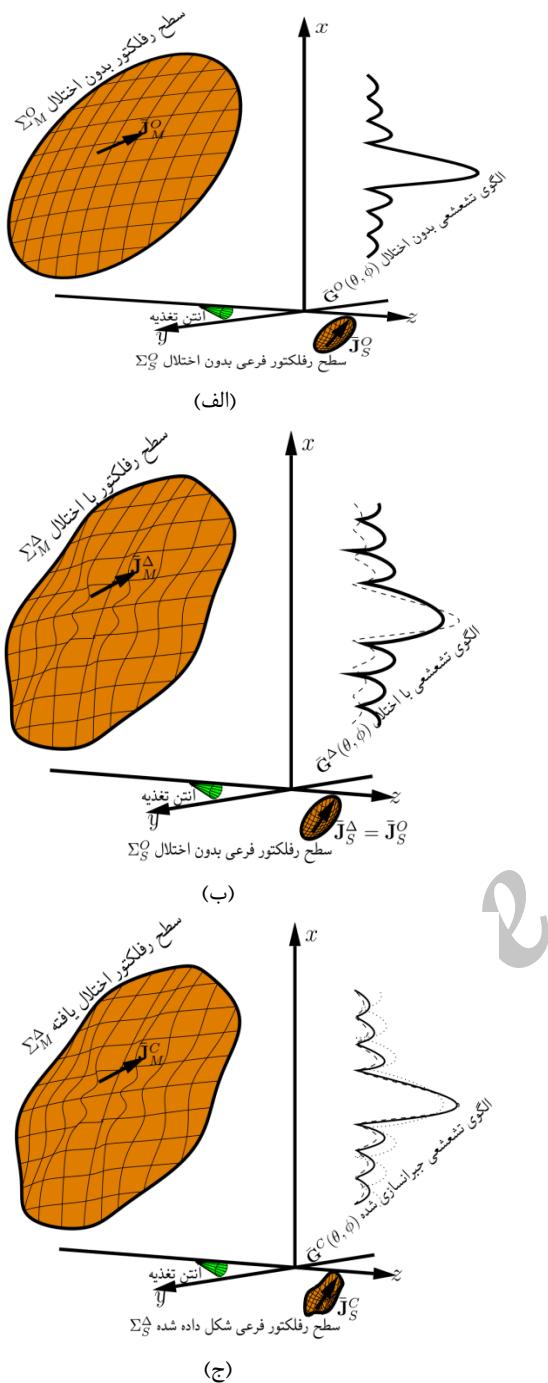
در [۴۵] بر اساس تقریبی که دارای دقتی کمتر از فرمول‌بندی پیشنهادی این مقاله است، روشی برای حل مسئله جبران‌سازی ارائه شده است. نحوه استخراج میدان مغناطیسی بهینه در این کار بسیار پیچیده است و در اینجا فرمول‌بندی بسیار ساده‌تری برای این کار ارائه خواهد شد. همچنین، به دلیل دقت بالاتر فرمول‌بندی این مقاله، سطوح بالاتری از اختلال (یک‌چهارم طول موج) برای سطوح منظور می‌شود، حال آن‌که در مقاله مذکور، این سطح تنها یک دهم طول موج است.

در ادامه ابتدا به معرفی ریاضیات تحلیل مسئله پرداخته شده و پس از آن، مسئله جبران‌سازی، تحلیل خواهد شد. با داشتن فرمول‌بندی، حل مسئله برای یک ساختار نمونه، یک بازتابنده جبران‌ساز طراحی خواهد شد و نمودارهای الگوی تشعشعی تشریح خواهد شد. در نهایت، در بخش آخر، جمع‌بندی مقاله ارائه خواهد شد.

## ۲- ریاضیات مسئله و فرمول‌بندی

در حالت کلی، سطح بازتابنده اصلی، سطح بازتابنده فرعی و آنتن تغذیه، اجزای اصلی در مسئله تحلیل آنتن‌های بازتابنده هستند. برای هر یک از این اجزا بایستی تحلیل‌های الکترومغناطیسی صورت پذیرد. از این‌رو بایستی هندسه هر یک از این اجزا شناسایی شود. در شکل (۱) این اجزا نمایش یافته‌اند.

ملاحظه می‌شود که برای بازتابنده اصلی، بازتابنده فرعی و آنتن تغذیه به صورت جداگانه دستگاه‌های مختصاتی فرض شده است که به ترتیب به صورت  $\{x_s, y_s, z_s\}$   $\{x_m, y_m, z_m\}$  و  $\{x_f, y_f, z_f\}$



شکل (۲). توصیف حالت‌های مختلف در حل مسئله جبران‌سازی.  
 (الف) ساختار ایده‌آل بدون اختلال که هدف از جبران‌سازی، بازتابنده‌گویی تشعشعی به صورت  $(\phi, \theta)$  است، (ب) ساختار اختلال یافته که اثرات اختلال سطح بازتابنده اصلی در آن سبب خرابشدن گلوگوی تشعشعی و تغییر آن به  $(\phi, \theta)$  شده و (ج) ساختار جبران‌سازی شده که در آن به تغییر شکل سطح بازتابنده فرعی، می‌توان گلوگوی تشعشعی  $(\phi, \theta)$  را تا حد ممکن به حالت ایده‌آل در شکل (الف) نزدیک نمود.

ماتریس  $[U]$  یک ماتریس  $M \times M$  و شامل مجموعه‌ای از بردارهای ویژه‌ی خروجی ماتریس  $[T]$  است. همچنین  $[V]$  نیز

## ۱-۲- خطی‌سازی انتگرال تشعشعی

در [۴۶] به این موضوع پرداخته شده است که با بروز اختلال بر سطح بازتابنده، تغییرات گلوگوی تشعشعی آتنن چگونه با رفتار تابع اختلال مرتبط است. تغییرات تابع میدان دور یک آتنن بازتابنده به دلیل ایجاد اختلال سطح عبارت است از:

$$\Delta G_{co} = G_{co}^{dis} - G_{co}^{undis} \approx \int_{\Psi} \int_t \left[ \hat{u}_{co} \cdot \frac{\delta \bar{F}[z]}{\delta z(t, \psi)} \right] \Delta z(t, \psi) dt d\psi \quad (5)$$

که در آن،  $\frac{\delta \bar{F}[z]}{\delta z(t, \psi)}$  مشتق وردشی است که در [۴۶] به دست آمده است. همچنین  $\hat{u}_{co}$  بردار یکه پلاریزاسیون اصلی است و طبق تعریف سوم لودویگ [۴۷] به دست می‌آید. متغیرهای  $t$  و  $\psi$  به صورت قطبی در دهانه بازتابنده اصلی تعریف می‌شوند تا انتگرال سطحی به انتگرال دوگانه تبدیل شود.

رابطه (۵) را می‌توان در فرم ماتریسی نیز ارائه نمود. چنان‌چه بخواهیم برای  $M$  نقطه مشاهده در زوایای  $(\phi_j, \theta_j)$  که در آن  $j = 1, \dots, M$  مسئله را حل کنیم، خواهیم داشت:

$$[\Delta G_{co}] = [T][\Delta z] \quad (6)$$

که در آن،  $[\Delta G_{co}]$  ماتریسی  $M \times 1$  به صورت  $[\Delta G_{co}(\theta_1, \phi_1), \dots, \Delta G_{co}(\theta_M, \phi_M)]^T$  و شامل تغییرات تابع میدان دور در راستای نقاط مشاهده است. همچنین ماتریس  $[T]$  یک ماتریس مستطیلی  $N \times M$  است که عنصر آن عبارتند از:

$$T_{ij} = \frac{\eta}{j\lambda} \left( \hat{u}_{co} \cdot \frac{\delta \bar{F}[z]}{\delta z(t_i, \psi_i)} \right) w_i. \quad (7)$$

همچنین ماتریس  $\Delta z$  ماتریسی  $N \times 1$  است و  $[\Delta z(t_1, \psi_1), \dots, \Delta z(t_N, \psi_N)]^T$  به صورتی تعریف می‌شود که شامل اختلال سطح در نقاط روی سطح بازتابنده است. به این ترتیب رابطه (۶)، فرم ماتریسی مسئله مستقیم است. با داشتن ماتریس اختلال  $[\Delta z]$  و تشکیل ماتریس سامانه  $[T]$ ، می‌توان تغییرات تابع میدان دور را از روی ماتریس  $[\Delta G_{co}]$  تعیین نمود.

## ۲-۲- حل مسئله معکوس: تعیین تابع اختلال

برای تعیین تابع اختلال از روی تغییرات میدان‌های تشعشعی، با مسئله معکوس رو به رو خواهیم بود. همان‌طور که در بخش قبل دیدیم، مسئله معکوس را مسئله مستقیم یعنی تعیین تغییرات میدان‌های تشعشعی از روی تابع اختلال با استفاده از رابطه (۶) قابل حل است. در این بخش با حل مسئله معکوس رابطه (۶) سروکار داریم.

بر اساس روش تفکیک مقداير و پيژه (SVD) در حالت کلی ماتریس مستطیلی  $[T]$  قابل بازنويسي به صورت حاصل ضرب سه ماتریس است [۴۸]:

$$[T]_{M \times N} = [U]_{M \times M} [\Sigma]_{M \times N} [V]^T_{N \times N} \quad (8)$$

اختلال سطح بازتابنده اصلی، سطح بازتابنده فرعی را به‌گونه‌ای تغییر شکل داد که الگوی تشبعشی جبران‌سازی شده ( $\bar{G}^C(\theta, \phi)$ ) به الگوی ایده‌آل ( $G^0(\theta, \phi)$ ) نزدیک باشد.

در شکل ۲-ج) هندسه مسئله جبران‌سازی آمده است. در این حالت میدان آنتن تغذیه بر روی سطح بازتابنده فرعی جبران‌سازی، یک جریان سطحی متفاوت  $\bar{J}_S^C = 2\hat{u}_{N_{\Sigma_M^C}}$  به صورت القاء می‌نماید. به همین ترتیب، سطح مختلف بازتابنده اصلی نیز دارای جریان سطحی  $\bar{H}_S^C = 2\hat{u}_{N_{\Sigma_M^C}} \times \bar{H}_S^0$  خواهد بود می‌شود و الگوی تشبعشی نهایی نیز ( $\bar{G}^C(\theta, \phi)$ ) خواهد بود.

## ۵-۲- فرمول‌بندی حل مسئله جبران‌سازی

در مسئله‌ی جبران‌سازی به دنبال آنیم که

$$\min \Delta G_{\text{co}}^C(\theta, \phi) = \|G_{\text{co}}^0(\theta, \phi) - G_{\text{co}}^C(\theta, \phi)\|, \quad (10)$$

for  $\theta < \theta_m$ , and  $0 < \phi < 2\pi$ ,

یا به عبارت دیگر، بایستی برای محدود مشاهده مطلوب اختلال الگوی تشبعشی جبران‌سازی شده با الگوی ایده‌آل کمینه گردد.

برای این کار بایستی ابتدا جریان القایی بهینه روی سطح بازتابنده اصلی به‌گونه‌ای تعیین گردد که بتواند تشبعش ( $G_{\text{co}}^0(\theta, \phi)$ ) را فراهم آورد. این جریان بهینه روی سطح بازتابنده اصلی عبارت است از:

$$\bar{J}_M^{\text{C, opt}} = \bar{J}_M^0 e^{-jk\Delta z_M} \quad (11)$$

که در آن  $\Delta z_M$  همان اختلال موجود بر سطح بازتابنده اصلی است. با تقریب مناسبی می‌توان میدان مغناطیسی بهینه بر سطح بازتابنده اصلی و تشبعش یافته از بازتابنده فرعی را نیز از رابطه اخیر تعیین نمود:

$$\bar{H}_S^{\text{C, opt}} = \bar{H}_S^0 e^{-jk\Delta z_M}. \quad (12)$$

به این ترتیب می‌توان تغییرات میدان تابشی از بازتابنده فرعی بر بازتابنده اصلی را به دست آورد که عبارت است از:

$$\begin{aligned} \Delta \bar{H}_S^C &= \bar{H}_S^{\text{C, opt}} - \bar{H}_S^0 = \bar{H}_S^0 (e^{jk\Delta z_M} - 1) \\ &= -2j\bar{H}_S^0 e^{-jk\frac{\Delta z_M}{2}} \sin\left(k \frac{\Delta z_M}{2}\right) \end{aligned} \quad (13)$$

حال بایستی سطح بازتابنده فرعی به‌گونه‌ای تغییر شکل یابد که بتواند این تغییرات در میدان مغناطیسی بر روی نقاط بازتابنده اصلی را ایجاد نماید. ملاحظه می‌شود که در این حالت نیز با مسئله‌ای نظری مسئله تخمین رو به رو هستیم. به این معنی که تغییرات میدان تشبعشی از بازتابنده را داریم و به دنبال تغییرات سطح بازتابنده فرعی هستیم. این مسئله نیز به صورت ماتریسی قابل فرمول‌بندی است:

ماتریسی  $M \times M$  که مجموعه‌ای از بردارهای ویژه‌ی ورودی ماتریس  $[T]$  را شامل می‌شود. در نهایت ماتریس  $[\Sigma]$  یک ماتریس قطری  $N \times N$  است که عناصر قطر آن همان مقادیر ویژه ماتریس  $[T]$  هستند. همچنین عملگر  $[\cdot]^T$  به صورت ترانهاده مزدوج عمل می‌کند [۴۸-۴۹]. با استفاده از مفهوم شبے-معکوس در جبر خطی بر مبنای روش SVD می‌توان حل معکوس رابطه‌ی (۶) را بر مبنای رابطه‌ی (۸) به صورت زیر نوشت

$$[\Delta z] = [\mathbf{V}] [\Sigma]^+ [\mathbf{U}]^T [\Delta G_{\text{co}}]. \quad (9)$$

که  $[\Sigma]^+$  ترانهاده (transpose) ماتریس  $[\Sigma]$  است که در آن عناصر غیرصفر با معکوس آن‌ها جایگزین شده است.

## ۳-۲- توصیف مسئله آنتن دو بازتابنده‌ای

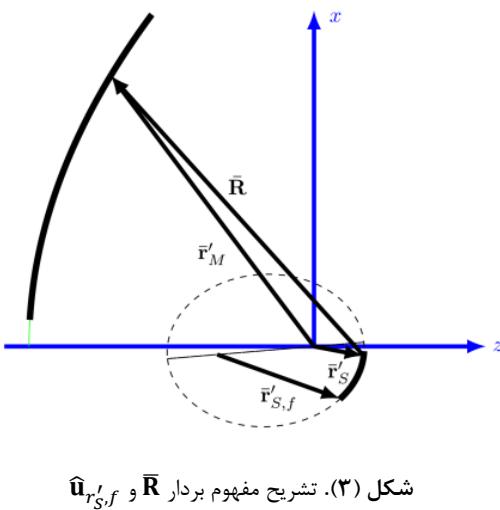
با توجه به شکل ۲-الف) می‌توان گفت که مسئله شامل سه جزء آنتن تغذیه، بازتابنده فرعی (سطح  $\Sigma_S^0$ ) و بازتابنده اصلی (سطح  $\Sigma_M^0$ ) است. بالا نویس ۰ برای توصیف سطحی است که مختلط نشده باشد. البته در شکل مذکور از هندسه گریگورین استفاده شده که در آن سطح بازتابنده فرعی به صورت محدب و بخشی از یک بیضی‌گون دوار است. در حالت کسگرین این سطح به صورت مقعر (بخشی از یک هذلولی) مطرح می‌شود.

میدان مغناطیسی تابشی از آنتن تغذیه  $\bar{H}^{\text{feed}}_S$  در برخورد با سطح بازتابنده فرعی سبب القای جریان سطح  $\bar{J}_S^0$  می‌گردد که در تقریب نور هندسی  $\bar{J}_S^0 = 2\hat{u}_{N_{\Sigma_S^0}} \times \bar{H}^{\text{feed}}$  قابل تقریب است. این جریان نیز میدان مغناطیسی تشبعشی  $\bar{H}_S^0$  را فراهم می‌آورد که با استفاده از رابطه (۲) به عنوان میدان تغذیه به سطح بازتابنده اصلی (سطح  $\Sigma_M^0$ ) می‌تابد. در نهایت با القای جریان سطحی  $\bar{J}_M^0$  می‌تابد.  $\bar{J}_M^0 = 2\hat{u}_{N_{\Sigma_M^0}} \times \bar{H}_M^0$  روى بازتابنده اصلی، عامل اصلی تشبعش آنتن فراهم می‌آيد. پترن تشبعشی نهایی آنتن را با (۸)  $\bar{G}^0(\theta, \phi)$  نمایش می‌دهند.

## ۴-۲- مسئله جبران‌سازی

با بروز اختلال بر سطح بازتابنده اصلی، با مسئله جدید روبه رو هستیم. این حالت در شکل ۴-ب) نمایش داده شده است. سطح اختلافی افته برای بازتابنده اصلی را با  $\Sigma_M^A$  نشان داده می‌شود که به دلیل اختلاف با سطح  $\Sigma_M^0$  جریان سطحی روی آن به تابع تشبعشی  $(\phi, \theta)$   $\bar{G}^A$  می‌گردد که با (۸)  $\bar{G}^0$  متفاوت است.

هدف از جبران‌سازی، نزدیک کردن این دو الگو به یکدیگر است. در بخش ۲-۲ به این مطلب پرداخته شد که چگونه می‌توان از روی تغییرات میدان تشبعشی  $G_p^A = G_p^0 - G_p^A$  تخمینی از اختلال سطح بازتابنده اصلی به دست آورد. به هر حال، آن‌چه در این بخش مطرح است آن است که چگونه می‌توان در حضور

شکل (۳). تشریح مفهوم بردار  $\bar{R}$  و  $\hat{u}_{r'_S,f}$ 

که در آن، ماتریس‌های  $[V_S]$ ،  $[\Sigma_S]$  و  $[U_S]$  با روش SVD تشریح شده در رابطه (۸) به دست می‌آیند.

## ۶-۲- فلوچارت پیشنهادی

برای یافتن سطح بازتابنده فرعی جبران‌ساز فلوچارتی همانند شکل (۴) ارائه نمود. براساس این الگوی حل مسئله، می‌توان حلقه تکرار تعیین سطح را تا آن جا تکرار نمود که بهره محوری در ساختار جبران‌سازی شده به بهره ساختار ایده‌آل نزدیک گردد. البته در عمل با انتخاب مناسب الگوی نمونه‌برداری از سطح بازتابنده‌ها، تعداد این تکرارها محدود است و همگرایی به نحو مناسبی رخ می‌دهد.

با انتخاب مناسب تعداد نقاط روی سطح بازتابنده فرعی و اصلی می‌توان دقیق و همگرایی پاسخ‌ها را بهبود داد. بر همین اساس در بخش بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

## ۷-۲- نکات مرتبط با دقیق و همگرایی روش

### پیشنهادی

براساس تئوری نایکوئیست، انتخاب مناسب تعداد و محل نقاط مشاهده سبب همگرایی روش شده و مسئله را از حالت بد وضعیتی خارج می‌سازد. در مسئله جبران‌سازی نقاط مشاهده روی سطح بازتابنده اصلی واقع هستند. از این نقطه نظر بایستی نمونه‌برداری از سطح بازتابنده اصلی به صورت شبکه‌بندی مستطیلی (ونه دایره‌ای) صورت پذیرد. همچنین فاصله‌گذاری این نقاط بایستی بزرگ‌تر از نیم طول موج باشد. به این ترتیب می‌توان عدد وضعیت ماتریس  $[T_{S,p}]$  را کنترل نمود و همگرایی روش را محقق کرد.

$$[\Delta H_{M,p}] = [T_{S,p}] [\Delta z_S] \quad (14)$$

که در آن،  $[\Delta z_S]_{N_{\Sigma_S} \times 1}$  بردار شامل تغییرات سطح در نقاط مختلف (نقطه  $N_{\Sigma_S}$  بازتابنده فرعی) است. همچنین  $[\Delta H_{M,p}]_{N_{\Sigma_M} \times 1}$  برداری است شامل تغییرات میدان تشعشعی از بازتابنده فرعی که روی  $N_{\Sigma_M}$  نقطه از سطح بازتابنده اصلی اختلال یافته  $\Sigma_M^A$  ارزیابی می‌شود. ماتریس  $[T_{S,p}]$  همان ماتریس سامانه است که در بخش ۱-۲ معرفی شد:

$$T_{S,p}(i,j) = -jk \left( \hat{u}_p(\theta_j, \phi_j) \cdot \frac{\delta \bar{F}_S}{\delta z_S(t_i, \psi_i)} \right) w_i, \quad (15)$$

که در آن،  $\frac{\delta \bar{F}_S}{\delta z_S(t_i, \psi_i)}$  مشتق تابعی انتگرال تشعشعی برای بازتابنده فرعی است. به دلیل ارزیابی میدان تشعشعی بازتابنده فرعی در میدان نزدیک، تفاوت‌هایی در فرمول مشتق وردیشی وجود دارد. بردار پلاریزاسیون  $\hat{u}_p$  نیز با توجه به پلاریزاسیون تغذیه به گونه‌ای انتخاب می‌شود که بیشترین دامنه برای میدان‌های مغناطیسی حاصل شود.

مشتق وردیشی در رابطه (۱۵) به صورت

$$\begin{aligned} & \hat{u}_p(\theta_j, \phi_j) \cdot \frac{\delta \bar{F}_S}{\delta z_S(t_i, \psi_i)} = \\ & jk \left[ \left[ \left( (\hat{u}_R - \hat{u}_{r'_j}) \cdot \hat{u}_z \right) \bar{N}_{\Sigma_S} + \hat{u}_z \times \right. \right. \\ & \left. \left. \left[ \left( \bar{N}_{\Sigma_S} \times \hat{u}_R - (\hat{u}_z \cdot \bar{N}_{\Sigma_S}) (\hat{u}_z \times \hat{u}_{r'_j}) \right) \right] \times \hat{H} \right] \right] \quad (16) \end{aligned}$$

$$(\hat{u}_p \times \hat{u}_R) \frac{e^{-jk|\bar{R}|}}{4\pi|\bar{R}|} \left( 1 + \frac{1}{jk|\bar{R}|} \right)$$

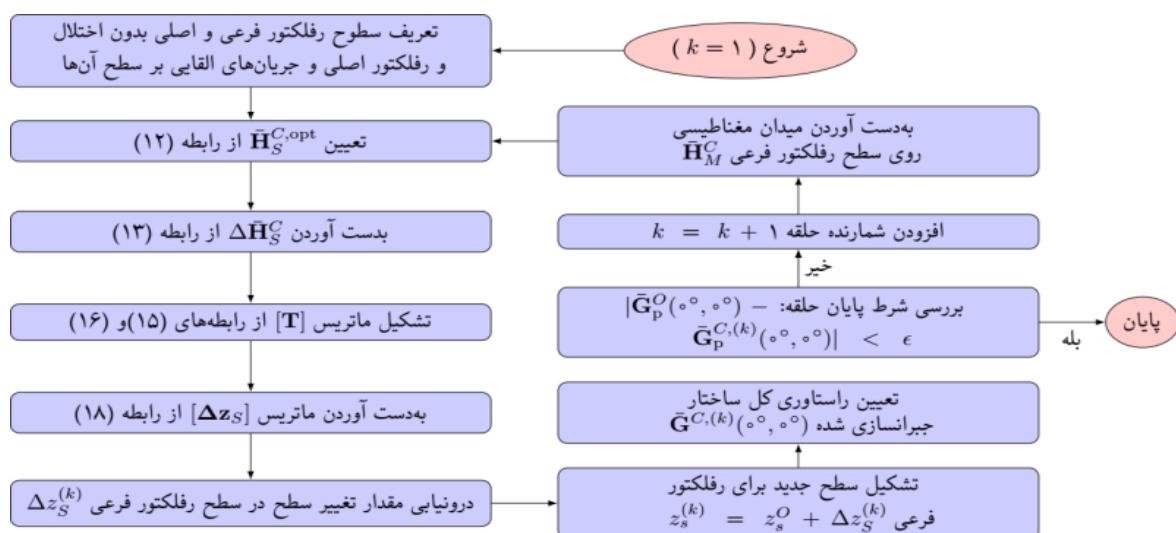
قابل فرمول‌بندی است که در آن، بردار  $\bar{R}$  عبارت است از بردار فاصله نقاط بازتابنده اصلی و فرعی و  $\hat{u}_{r'_S,f}$  بردار یکه نقاط سطح بازتابنده فرعی در دستگاه مختصات آن تن تغذیه یعنی  $\bar{r}_{S,f}$  است که این بردارها در شکل (۳) نمایش داده شده‌اند.

$$\bar{R} = \bar{r}_M - \bar{r}_S, \quad (17)$$

با ارزیابی مشتق وردیشی در رابطه (۱۶) می‌توان ماتریس سامانه در رابطه (۱۵) را به دست آورد. از سوی دیگر تغییرات میدان مغناطیسی از بازتابنده فرعی از رابطه (۳) تعیین می‌شود. در نهایت با داشتن ماتریس  $[T_{S,p}]$  و بردار  $[\Delta H_{M,p}]$  در رابطه (۱۴) می‌توان بردار  $[\Delta z_S]$  را از طریق روش ارائه‌شده در رابطه (۹) به دست آورد.

مشابه رابطه (۹) در مورد تغییر شکل بازتابنده فرعی نیز می‌توان نوشت:

$$[\Delta z_S] = [V_S] [\Sigma_S]^+ [U_S]^* [\Delta H_{M,p}] \quad (18)$$



شکل (۴). فلوچارت روش پیشنهادی برای طراحی بازتابنده فرعی جهت جبران‌سازی اختلال سطح بازتابنده اصلی.

نموده و نشان داده می شود که مسئله جبران‌سازی بر اساس فلوچارت ارائه شده در شکل (۴) و فرمول‌بندی ارائه شده قابل حل است.

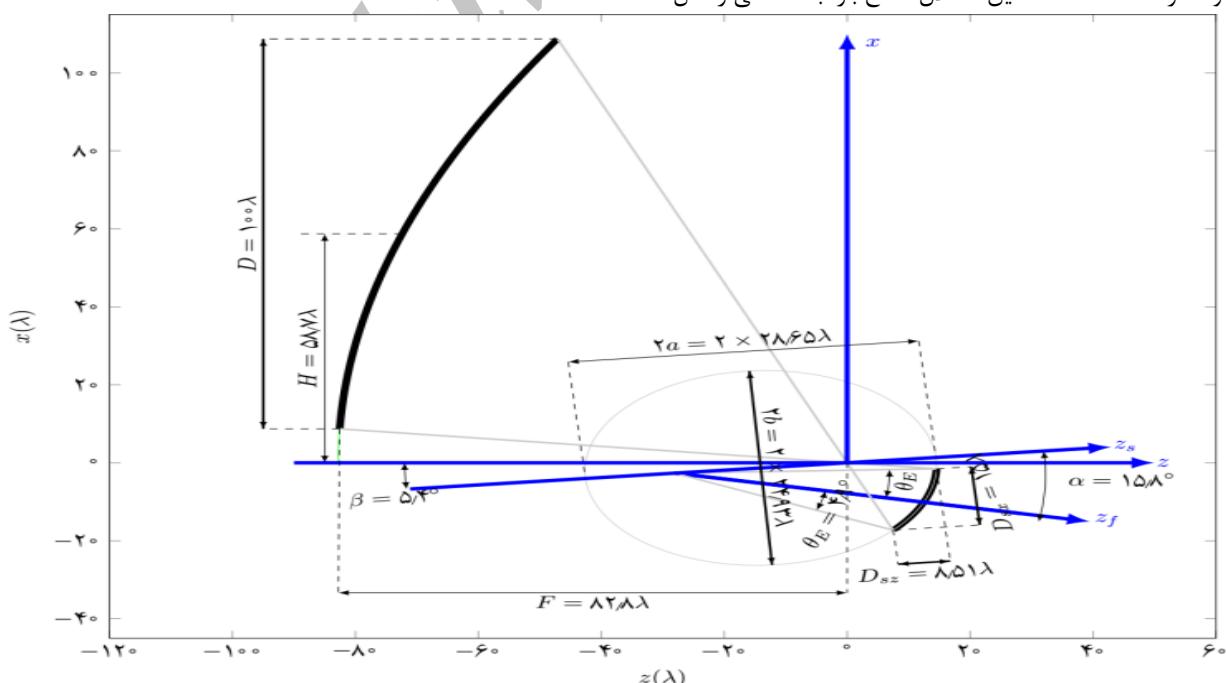
### ۳- توصیف مسئله نمونه

براساس معادلات طراحی ارائه شده در [۵۰-۵۱] یک ساختار گریگورین با پارامترهای معرفی شده در جدول (۱) به عنوان ساختار نمونه مورد بررسی قرار گرفته است و این آنتن در شکل (۵) ترسیم شده است.

### ۳- نتایج

در این بخش به حل یک مسئله جبران‌سازی پرداخته می‌شود. ابتدا هندسه مسئله مذکور و جزئیات طراحی آن ارائه شده و الگوی تشعشعی آنتن مذکور استخراج می‌شود. پس از آن نوعی از اختلال روی سطح بازتابنده اصلی اعمال می‌شود و اثرات این اختلال بر الگوی تشعشعی بررسی می‌شود.

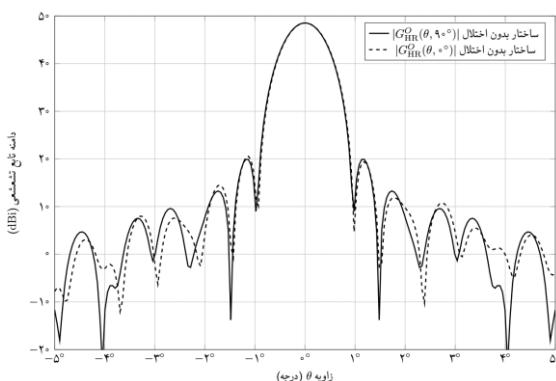
نشان خواهیم داد که با تحقق میدان مغناطیسی بهینه  $\bar{H}_M^{\text{opt}}$  روی سطح بازتابنده مختل، می‌توان اثرات اختلال را جبران‌سازی نمود. در ادامه مسئله تخمین اختلال سطح بازتابنده اصلی را حل



شکل (۵). آنتن دوبازتابنده‌ای گریگورین آفست در نظر گرفته شده به عنوان ساختار مرجع در حل مسئله جبران‌سازی. پارامترهای جزئی‌تر این ساختار در جدول (۱) آمده است.

$\phi = \pm 1.78^\circ$  هستند. در صفحه  $\theta = 0^\circ$  شاهد عدم تقارن در الگوی تشعشعی هستیم که ناشی از عدم تقارن هندسی است. در این صفحه گلبرگ اول در زوایای مثبت دارای سطح  $19.4 \text{ dBi}$  در زاویه  $\phi = \pm 1.18^\circ$  و گلبرگ اول در زوایای منفی نیز دارای سطح  $20.55 \text{ dBi}$  در زاویه  $\phi = \pm 1.13^\circ$  واقع می‌شوند. اختلالی از نوع سینوسی به صورت

$$\Delta z_M(t, \psi) = \lambda / 4t^3 \sin(3\psi), \quad (19)$$



شکل (۶). الگوی تشعشعی برای آنتن دوبازتابندهای مرتعبدون اختلال توصیف شده در شکل (۵) و جدول (۱) در دو صفحه اصلی  $\phi = 0^\circ$  (خط بردیده) و  $\phi = 90^\circ$  (خط ممتد)

به سطح بازتابنده فرعی اعمال می‌گردد. این نوع اختلال در مرکز برابر با صفر و در لبه‌ها بیشینه می‌شود. اختلالی از این نوع از متدالوں ترین حالات اختلال سطح محاسبه می‌شود که برای مدل‌سازی اثرات ناشی از گرانش یا حرارت بر تغییر سطح بازتابنده مورد استفاده قرار می‌گیرد [۶، ۱۹، ۷، ۴۵]. چنین اختلالی سبب تغییر رفتار الگوی تشعشعی خواهد شد. در شکل (الف) الگوی تشعشعی بدون اختلال و با اختلال در صفحه  $\phi = 0^\circ$  نشان داده شده است. ملاحظه می‌شود که در مقایسه با شکل (۶)، جهت‌مندی به اندازه  $1.65 \text{ dBi}$  کاهش یافته و به مقدار  $26.74 \text{ dBi}$  رسیده است. همچنین گلبرگ اول از مقدار  $19.4 \text{ dBi}$  در حالت بدون اختلال، به سطح  $26.74 \text{ dBi}$  رسیده که معادل افزایش حدود  $7.35 \text{ dB}$  است. همچنین برای صفحه  $\phi = 90^\circ$  الگوی تشعشعی اختلال یافته به صورت شکل (۷-ب) خواهد بود. ملاحظه می‌شود که اختلال ظاهر شده تا چه حد در عدم تقارن الگوی تشعشعی موثر است. به گونه‌ای که در زوایای منفی پدیده افزایش عرض پرتو اصلی و ظهور شانه به جای گلبرگ را شاهد هستیم. همچنین در زوایای مثبت گلبرگ اول به سطح  $32.67 \text{ dBi}$  رسیده که در مقایسه با حالت بدون اختلال حدود  $13.27 \text{ dB}$  افزایش یافته است. چنین تغییری در ویژگی‌های الگوی تشعشعی تهه در اثر اعمال اختلالی با دامنه یک‌چهارم طول موج رخ می‌دهد!

جدول (۱). پارامترهای طراحی برای ساختار دوبازتابندهای نمونه جهت بررسی روش جبران‌سازی

پارامتر	نماد پارامتر	مقدار/وضعیت
قطر رفلکتور اصلی	D	$100\lambda$
فاصله کانونی رفلکتور اصلی	F	$82.8\lambda$
ارتفاع آنتن رفلکتور اصلی	H	$58.7\lambda$
نم‌قطر بزرگ بیضی‌گون	a	$28.8\lambda$
نم‌قطر کوچک بیضی‌گون	b	$24.93\lambda$
خروج از مرکز بیضی‌گون	e	$0.4912\lambda$
قطر رفلکتور فرعی در راستای محور z	$D_{sx}$	$15\lambda$
قطر رفلکتور فرعی در راستای محور z	$D_{sz}$	$8.5\lambda$
زاویه بین محور بیضی‌گون و آنتن تغذیه	$\alpha$	$158^\circ$
زاویه بین محور بیضی‌گون و سهیمی‌گون	$\beta$	$54^\circ$
پلاریزاسیون آنتن تغذیه	$\hat{\mathbf{u}}_p$	$\hat{\mathbf{u}}_{HR}$
باریکشدنگی به برای الگوی تشعشعی آنتن تغذیه	ET	$-15 \text{ dB}$
زاویه‌ی به برای آنتن تغذیه	$\theta_E$	$48^\circ$
پارامتر پرتوگاوسی الگوی تشعشعی آنتن تغذیه	$b_H$	$0.3804$

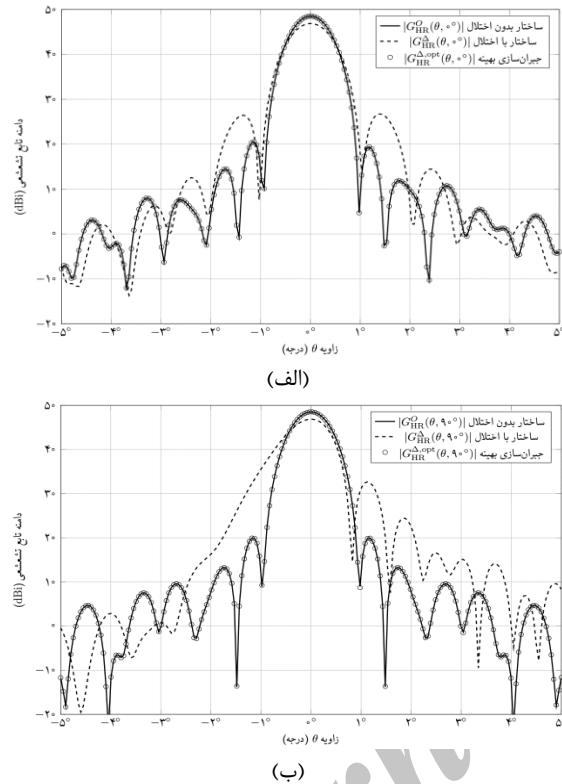
زاویه بین محور سهیمی‌گون و بیضی‌گون (زاویه  $\beta$ ) و زاویه بین محور آنتن تغذیه و محور بیضی‌گون (زاویه  $\alpha$ ) دو پارامتر اساسی در طراحی ساختارهای دوبازتابندهای هستند. با انتخاب مناسب این دو زاویه می‌توان میزان پلاریزاسیون متعامد را صفر کرد که به این شرط، شرط میزوگوچی می‌گویند [۵۱]. چنین شرطی در پارامترهای جدول (۱) رعایت شده است.

در آنتن مرتعبدون، قطر بازتابنده اصلی  $D = 100\lambda$  بوده و دارای فاصله کانونی  $F = 82.8\lambda$  است. ارتفاع آفست برای بازتابنده اصلی  $H = 58.7\lambda$  انتخاب شده است. بازتابنده فرعی دارای نیم قطر اصلی  $a = 28.8\lambda$  و نیم قطر فرعی  $b = 24.93\lambda$  بوده و محور آن با محور بازتابنده اصلی، زاویه  $\beta = 5.4^\circ$  را می‌سازد. آنتن تغذیه با پلاریزاسیون افقی  $\hat{\mathbf{u}}_{HR}$  و الگوی تشعشعی گاوسی به کار گرفته شده که دارای زاویه لمبه‌ی به اندازه  $\theta_E = 11.9^\circ$  با باریکشدنگی تشعشعی  $ET = -15 \text{ dB}$  (پارامتر گاوسی  $b_H = 0.3804$ ) است. آنتن تغذیه واقع بر کانون بیضی‌گون بوده و با محور بیضی‌گون زاویه  $\alpha = 15.8^\circ$  می‌سازد. با این پارامترهای طراحی، قطر دهانه بازتابنده فرعی در راستای محورهای  $x_s$  و  $z_s$  به ترتیب  $D_{sx} = 15\lambda$  و  $D_{sz} = 8.5\lambda$  خواهد بود.

برای آنتن دوبازتابندهای معروفی شده، طبق روال تحلیل ارائه شده در بخش ۲ شبیه‌سازی‌های عددی با روش نور فیزیکی صورت پذیرفته است. نتیجه تحلیل در شکل (۶) آمده است.

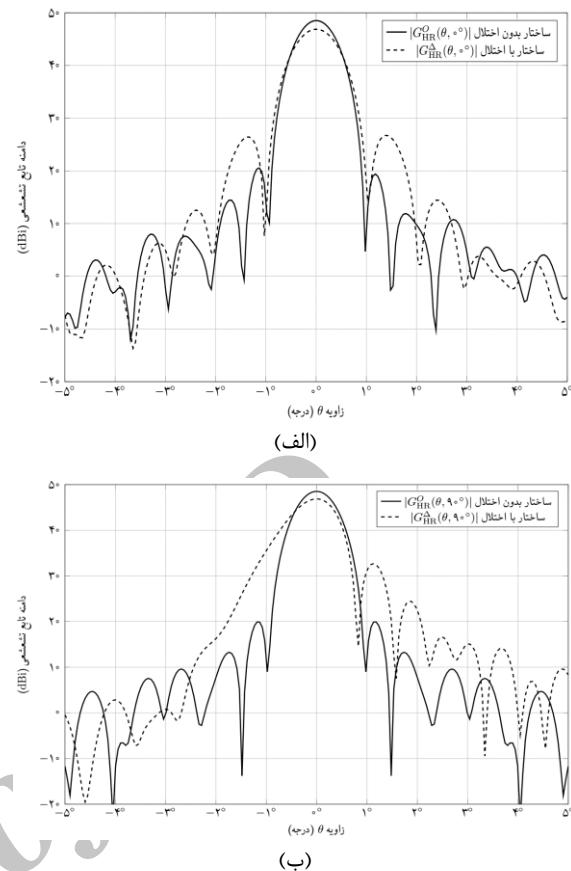
نتایج برای دو صفحه اصلی  $\phi = 0^\circ$  و  $\phi = 90^\circ$  نشان داده شده‌اند. ملاحظه می‌شود که جهت‌مندی این آنتن برای  $|G_{HR}(0^\circ, 0^\circ)| = 48.5 \text{ dBi}$  در راستای محور z است. در صفحه  $\phi = 90^\circ$  که صفحه تقارن هندسی ساختار محاسبه می‌شود، شاهد الگوی کاملاً متقاضی هستیم و گلبرگ‌های اول و دوم به ترتیب دارای سطوح  $19.4 \text{ dBi}$  در  $\phi = \pm 1.18^\circ$  و  $11.9 \text{ dBi}$  در

در شکل‌های (۸-الف) و (۸-ب) نتیجه اعمال میدان بهینه بر سطح بازتابنده اختلال یافته  $|G_{\text{HR}}^{\text{C, opt}}(\theta, \phi)|$  برای هر دو صفحه  $\phi = 0^\circ$  و  $\phi = 90^\circ$  آمده است. ملاحظه می‌شود که الگوی تشعشعی در این حالت بسیار به حالت ایده‌آل  $|G_{\text{HR}}^0(\theta, \phi)|$  نزدیک است. به عبارت دیگر با تحقق میدان مغناطیسی ایده‌آل  $H_S^{\text{C, opt}}$  بر سطح بازتابنده اصلی می‌توان اثرات اختلال سطح بازتابنده اصلی را جبران‌سازی نمود.



شکل (۸). الگوی تشعشعی برای آنتن دوبازتابندهای با اختلال میدان مغناطیسی بهینه بر سطح بازتابنده اصلی مختلف، (دوایر توخالی) و آنتن با اختلال (خط ممتد) توصیف شده در شکل (۵) و جدول (۱) و آنتن با اختلال (خط بریده) توصیف شده در رابطه (۱۶) در دو صفحه اصلی  $\phi = 0^\circ$  و (ب)  $\phi = 90^\circ$

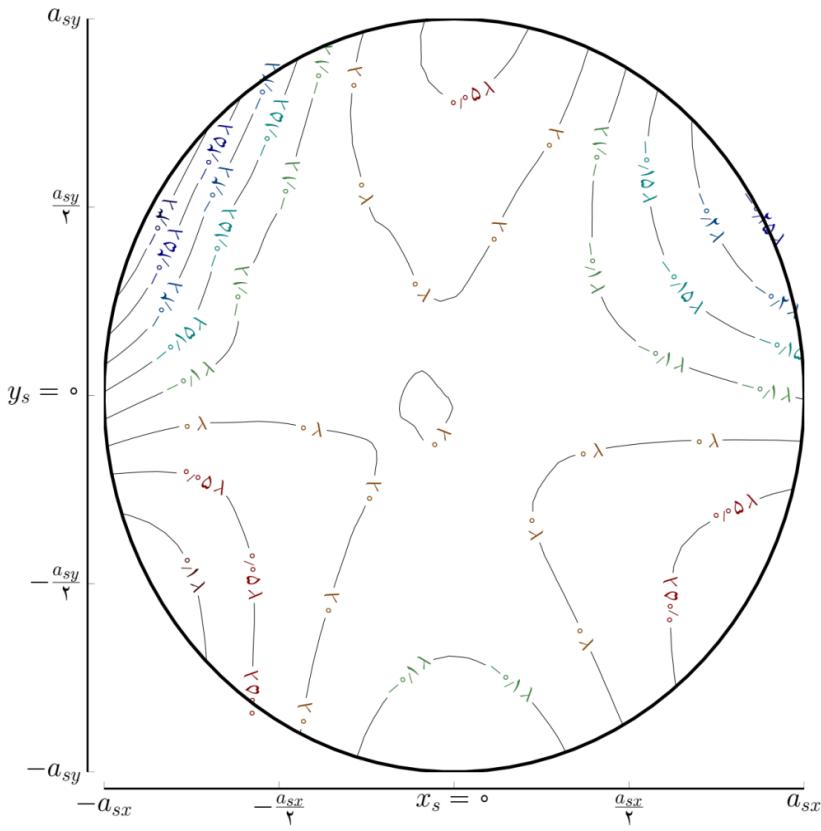
با داشتن تغییرات لازم در میدان مغناطیسی تشعشعی از رفکتور فرعی روی نقاط بازتابنده اصلی اختلال یافته، گام بعدی عبارت است از: تخمین تغییرات لازم روی سطح بازتابنده جهت رسیدن به این تغییرات لازم. نتیجه تخمین تغییرات لازم برای سطح بازتابنده فرعی در شکل (۹) آمده است. ملاحظه می‌شود که تغییرات لازم بر سطح بازتابنده فرعی نیز رفتار مشابه اختلال بازتابنده اصلی (سینوسی) داشته و دامنه آن در اکثر نقاط کمتر دامنه اختلال سطح بازتابنده اصلی (یکچهارم طول موج) است.



شکل (۷). الگوی تشعشعی برای آنتن دوبازتابندهای مرجع بدون اختلال (خط ممتد) توصیف شده در شکل (۵) و جدول (۱) و آنتن با اختلال (خط بریده) توصیف شده در رابطه (۱۶) در دو صفحه اصلی (الف)  $\phi = 0^\circ$  و (ب)  $\phi = 90^\circ$

### ۳-۲- شکل‌دهی سطح بازتابنده فرعی جهت جبران‌سازی اثرات اختلال سطح بازتابنده اصلی

در این بخش به چگونگی طراحی سطح بازتابنده فرعی جهت جبران‌سازی اثرات اختلال سطح بازتابنده فرعی خواهیم پرداخت. ابتدا نشان خواهیم داد که اعمال میدان مغناطیسی بهینه بر سطح بازتابنده اصلی چگونه می‌تواند سبب بهبود الگوی تشعشعی (حتی در حضور اختلال سطح) گردد. پس از آن، مسئله تخمین سطح را به گونه‌ای حل می‌کیم که میدان مغناطیسی بهینه بر سطح بازتابنده اصلی ایجاد شود. روال بهینه‌سازی تا آنجا پیش می‌رود که جهتمندی ساختار جبران‌سازی شده (شکل ۲-الف) تا حد ممکن به جهتمندی ساختار بدون اختلال (شکل ۲-ب) نزدیک شود. روال دقیق چنین روشی در فلوچارت شکل (۴) آمده است. تشخیص میدان مغناطیسی بهینه روی سطح بازتابنده اصلی اختلال یافته  $H_S^{\text{C, opt}}$  که ناشی از روابط از سطح بازتابنده فرعی است، از رابطه (۱۲) میسر است.



جدول (۲). خلاصه‌ای از پارامترهای اصلی جهت مقایسه ساختارهای ایده‌آل، مختل و جبران‌سازی شده بر اساس شکل (۱۰)

میزان بهبود	ساختار جبران‌سازی شده	ساختار اختلال یافته	ساختار ایده‌آل	کمیت
راستاواری	۴۸.۰ dB	۴۶.۸۵ dB	۴۸.۵ dB	
	۱/۱۵ dB	۸.۲ dB	۱۸.۵۴ dB	صفحه $\phi = 0^\circ$
صفحه $\phi = 90^\circ$	۳۸.۷ dB	۲۲.۵۶ dB	۲۶.۷۴ dB	گلبرگ اول منفی
	۱/۸۹ dB	۳۰.۹۸ dB	۳۲.۶۷ dB	گلبرگ اول مثبت
صفحه $\phi = 90^\circ$	۱/۱۲ dB	۲۲.۳۲ dB	۲۴.۴۴ dB	گلبرگ دوم مثبت
		۱۳.۲۸ dB	۱۹.۹۳ dB	

به‌گونه‌ای بازبینی نمود که با شکل دادن سطح بازتابنده فرعی، اثرات اختلال سطح بازتابنده اصلی جبران‌سازی گردد. بر مبنای این فرمول بندی، فلوچارتی پیشنهاد شد که با استفاده از آن با سرعت بالا و دقت مناسبی می‌توان بازتابنده فرعی جبران‌ساز را طراحی نمود. به عنوان مسئله نمونه، برای یک آنتن دوبازتابنده‌ای بزرگ همین فرمول بندی و روش پیشنهادی را اعمال نموده و نشان دادیم که به نحو بسیار کارآمدی می‌توان تحریب الگوی تشعشعی ناشی از اختلال سطح بازتابنده اصلی را با اصلاح سطح بازتابنده فرعی جبران‌سازی نمود.

## ۵- مراجع

- [1] S. K. Sharma, S. Rao, and L. Shafai, "Handbook of Reflector Antennas and Feed Systems," Volume I: Theory and Design of Reflectors, Artech house, 2013.
- [2] T. S. Bird, "Reflector Antennas," Singapore: Springer Singapore, pp.1–61, 2014.
- [3] Y. Rahmat-Samii and R. Haupt, "Reflector Antenna Developments: a Perspective on the Past, Present and Future," *Antennas and Propagation Magazine, IEEE*, vol. 57, pp. 85–95, April 2015.
- [4] D.-W. Duan and Y. Rahmat-Samii, "A Generalized Diffraction Synthesis Technique for High Performance Reflector Antennas," *Antennas and Propagation, IEEE Transactions on*, vol. 43, no. 1, pp. 27–40, 1995.
- [5] G. Cortés-Medellin and P. F. Goldsmith, "Analysis of Active Surface Reflector Antenna for a Large Millimeter Wave Radio Telescope," *Antennas and Propagation, IEEE Transactions on*, vol. 42, no. 2, pp. 176–183, 1994.
- [6] Y. Rahmat-Samii, "Effects of Deterministic Surface Distortions on Reflector Antenna Performance," in *Annales des télécommunications*, vol. 40, pp. 350–360, Springer, 1985.
- [7] J. Ruze, "Antenna Tolerance Theory-a Review," in *IEEE Proceedings*, vol. 54, pp. 633–642, 1966.
- [8] M. S. Zarghamee, "On Antenna Tolerance Theory," *Antennas and Propagation, IEEE Transactions on*, vol. 15, no. 6, pp. 777–781, 1967.
- [9] S. Ghobrial, "Axial Cross Polarization in Reflector Antennas with Surface Imperfections," *Antennas and Propagation, IEEE Transactions on*, vol. 28, no. 5, pp. 610–616, 1980.
- [10] J. Jervase, S. Ghobrial, et al., "Axial Cross Polarization in Reflector Antennas with Surface Errors of Large Correlation Diameter," *Antennas and Propagation, IEEE Transactions on*, vol. 31, no. 4, pp. 662–665, 1983.
- [11] H. Ling, Y. T. Lo, and Y. Rahmat-Samii, "Reflector Sidelobe Degradation due to Random Surface Errors,"

جدول (۲) خلاصه‌ای از مقایسه پارامترهای اساسی بین سه ساختار ایده‌آل، مختل و جبران‌سازی شده را ارائه می‌کند.

با توجه به شکل (۱۰) می‌توان گفت که جهتمندی ساختار که در حالت ایده‌آل برابر 48.5 dB است، به دلیل اختلال سطح بازتابنده اصلی با ۱.65 dBی افت (یعنی ۳۱ درصد کاهش)، به سطح 46.85 dB رسیده بود، با استفاده از بازتابنده فرعی شکل یافته و جبران‌سازی به سطح 48.0 dB رسید که تنها ۱۰ درصد کمتر از حالت ایده‌آل کمتر است. به عبارت دیگر، با استفاده از جبران‌سازی توانسته‌ایم بیش از ۱ dB افت جهتمندی را جبران‌سازی کنیم.

با توجه به شکل (۱۰-الف) که نشان دهنده الگوی تشعشعی در صفحه  $\phi = 0^\circ$  است، شاهدیم که سطح گلبرگ‌های کناری به خوبی جبران‌سازی شده است. سطح گلبرگ اول در زوایای مثبت که از مقدار 19.4 dB در حالت ایده‌آل، به مقدار 26.74 dB در حالت مختل رسیده است، با استفاده از بازتابنده فرعی شکل یافته به سطح 18.54 dB رسید که معادل بیش از 8 dB بهبود است. برای گلبرگ اول در زوایای منفی این بهبود حدود 4 dB است.

با توجه به شکل (۱۰-ب) نیز می‌توان ملاحظه نمود که بهبود در سطح گلبرگ‌های الگوی تشعشعی در صفحه  $\phi = 90^\circ$  به خوبی صفحه‌ی دیگر نیست، اگرچه که میزانی از بهبود قابل مشاهده است. با استفاده از جبران‌سازی، برای گلبرگ اول و دوم در زوایای مثبت به ترتیب حدود 2 dB و 1 dB کاهش سطح گلبرگ‌ها را شاهد هستیم.

بدین ترتیب، می‌بینیم که بازتابنده فرعی شکل یافته می‌تواند به خوبی اثرات اختلال سطح بازتابنده اصلی را جبران‌سازی کند و برای طراحی چنین سطحی، روش پیشنهادی توسط مقاله حاضر کارآمد خواهد بود.

## ۴- نتیجه‌گیری

مهمترین عامل محدود کننده حد بالای فرکانس برای عملکرد صحیح آنتن بازتابنده، اختلال‌هایی است که بر سطح بازتابنده ظاهر می‌شود. در این مقاله نشان داده شد که چگونه می‌توان با استفاده از یک فرمول بندی جدید، مسئله آنتن دو بازتابنده‌ای را

- transactions on antennas and propagation, vol. 53, no. 8, pp. 2590–2596, 2005.
- [27] J. W. Baars, “The Paraboloidal Reflector Antenna in Radio Astronomy and Communication,” Springer, 2007.
- [28] Y. Rahmat-Samii, “Microwave Holography of Large Reflector Antennas—Simulation Algorithms,” IEEE Transactions on antennas and Propagation, vol. 33, no. 11, pp. 1194–1203, 1985.
- [29] Y. Rahmat-Samii, “Surface Diagnosis of Large Reflector Antennas Using Microwave Holographic Metrology: an Iterative Approach,” Radio Science, vol. 19, no. 5, pp. 1205–1217, 1984.
- [30] J. Bennett, A. Anderson, P. McInnes, and A. Whitaker, “Microwave Holographic Metrology of Large Reflector Antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 24, no. 3, pp. 295–303, 1976.
- [31] G. Harp, R. Ackermann, et al., “Primary Beam and Dish Surface Characterization at the Allen Telescope Array by Radio Holography,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 59, no. 6, pp. 2004–2021, 2011.
- [32] G. R. Harp, “private communication,” 2013–2015.
- [33] W. A. Imbriale, “Distortion Compensation Techniques for Large Reflector Antennas,” in Aerospace Conference, 2001, IEEE Proceedings, vol. 2, pp. 2–799, 2001.
- [34] R. Paradies and M. Hertwig, “Shape Control of Adaptive Composite Reflectors,” Composites Part B: Engineering, vol. 30, no. 1, pp. 65–78, 1999.
- [35] D. Gorinevsky and T. T. Hyde, “Adaptive Membrane for Large Lightweight Space Telescopes,” in Astronomical Telescopes and Instrumentation, pp. 330–338, International Society for Optics and Photonics, 2002.
- [36] “Five hundred meter aperture spherical telescope,” <http://www.fast.bao.ac.cn/>.
- [37] “The 305m telescope,” <http://www.naic.edu/>.
- [38] R. J. Acosta, “Active Feed Array Compensation for Reflector Antenna Surface Distortions,” 1988.
- [39] A. R. Cherrette, R. J. Acosta, P. T. Lam, and S.-W. Lee, “Compensation of Reflector Antenna Surface Distortion Using an Array Feed,” IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 37, no. 8, pp. 966–978, 1989.
- [40] N. Amitay and H. Zucker, “Compensation of Spherical Reflector Aberrations by Planar Array Feeds,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 20, no. 1, pp. 49–56, 1972.
- [41] Y. Rahmat-Samii, “Array Feeds for Reflector Surface Distortion Compensation: Concepts and Implementation,” IEEE Antennas and Propagation Magazine, vol. 32, no. 4, pp. 20–26, 1990.
- [42] S. Xu, Y. Rahmat-Samii, and W. A. Imbriale, “Subreflectarrays for Reflector Surface Distortion Compensation,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 57, no. 2, pp. 364–372, 2009.
- [43] P. R. Lawson and J. L. Yen, “A Piecewise Deformable Subreflector for Compensation of Cassegrain Main Reflector Errors,” IEEE transactions on antennas and propagation, vol. 36, no. 10, pp. 1343–1350, 1988.
- [44] P. Cowles and E. Parker, “Reflector Surface Error Compensation in Cassegrain Antennas,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 23, no. 3, pp. 323–328, 1975.
- [45] B. Gonzalez-Valdes, J. A. Martinez-Lorenzo, C. Rappaport, and A. G. Pino, “A New Physical Optics Based Approach to Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 34, no. 2, pp. 164–172, 1986.
- [12] P. Lian, B. Duan, W. Wang, B. Xiang, and N. Hu, “Effects of non-Uniform Surface Errors Along the Radius on Reflector’s Radiation Characteristic and Its Quality Evaluation,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 63, no. 5, pp. 2312–2316, 2015.
- [13] R. P. Corkish, “A Survey of the Effects of Reflector Surface Distortions on Sidelobe Levels,” Antennas and Propagation Magazine, IEEE, vol. 32, no. 6, pp. 6–11, 1990.
- [14] P. Rocca, N. Anselmi, and A. Massa, “Interval Arithmetic for Pattern Tolerance Analysis of Parabolic Reflectors,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 62, no. 10, pp. 4952–4960, 2014.
- [15] J.-W. Kim, B. S. Kim, S. Nam, and C. W. Lee, “Computation of the Average Power Pattern of a Reflector Antenna with Random Surface Errors and Misalignment Errors,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 44, no. 7, pp. 996–999, 1996.
- [16] S. Zhang, B. Duan, H. Bao, and P. Lian, “Sensitivity Analysis of Reflector Antennas and Its Application on Shaped Geo-Truss Unfurlable Antennas,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 61, no. 11, pp. 5402–5407, 2013.
- [17] K. Bahadori and Y. Rahmat-Samii, “Characterization of Effects of Periodic and Aperiodic Surface Distortions on Membrane Reflector Antennas,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 53, no. 9, pp. 2782–2791, 2005.
- [18] A. Greve and D. Morris, “Repetitive Radio Reflector Surface Deformations,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 53, no. 6, pp. 2123–2126, 2005.
- [19] W. T. Smith and R. J. Bastian, “An Approximation of the Radiation Integral for Distorted Reflector Antennas Using Surface-Error Decomposition,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 45, no. 1, pp. 5–10, 1997.
- [20] T.-H. Lee, R. Ruddock, and M. C. Bailey, “A Surface Distortion Analysis Applied to the Hoop/Column Deployable Mesh Reflector Antenna,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 37, no. 4, pp. 452–458, 1989.
- [21] Y. Zong, B. Duan, Y. Ban, W. Wang, W. Xu, C. Wang, and J. Du, “Surface Configuration Design of Cable-Network Reflectors Considering the Radiation Pattern,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 62, no. 6, pp. 3163–3173, 2014.
- [22] R. J. Langley and E. A. Parker, “Wave Scattering from Error-Compensating Secondary Reflectors,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 27, pp. 527–530, 1979.
- [23] B. M. Thomas and P. Rayner, “Effect of Surface Distortions on the Crosspolarisation Performance of Paraboloidal Reflectors,” Electronics Letters, vol. 13, no. 16, pp. 478–480, 1977.
- [24] K. Chan and A. Raab, “Surface-Current Analysis of Distorted Reflector Antennas,” Microwaves, Optics and Antennas, IEEE Proceedings H, vol. 128, no. 4, pp. 206–212, 1981.
- [25] R. Hoferer, Y. Rahmat-Samii, et al., “Subreflector Shaping for Antenna Distortion Compensation: an Efficient Fourier-Jacobi Expansion with GO/PO Analysis,” Antennas and Propagation, IEEE Transactions on, vol. 50, no. 12, pp. 1676–1687, 2002.
- [26] R. Subrahmanyan, “Photogrammetric Measurement of the Gravity Deformation in a Cassegrain Antenna,” IEEE

- [49] J. A. Martinez-Lorenzo, C. M. Rappaport, and A. G. Pino, "Reflector Antenna Distortion Determination: an Iterative-Field-Matrix Solution," *Radio Science*, vol. 43, no. 4, 2008.
- [50] C. Granet, "Designing Axially Symmetric Cassegrain or Gregorian Dual-Reflector Antennas from Combinations of Prescribed Geometric Parameters, Minimum Blockage Condition While Taking into Account the Phase-Center of the Feed," *Antennas and Propagation Magazine, IEEE*, vol. 40, no. 3, pp. 82–89, 1998.
- [51] C. Granet, "Designing Classical Offset Cassegrain or Gregorian Dual-Reflector Antennas from Combinations of Prescribed Geometric Parameters," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, vol. 44, no. 3, pp. 114–123, 2002.
- [46] A. Haddadi and A. Ghorbani, "Subreflector Shaping for Reflector Antenna Distortion Compensation," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 61, no. 1, pp. 467–472, 2013.
- [47] A. Haddadi and A. Ghorbani, "Distorted Reflector Antennas: Analysis of Radiation Pattern and Polarization Performance," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 64, no. 10, pp. 4159–4167, 2016.
- [48] A. Ludwig, "The Definition of Cross Polarization," *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 21, no. 1, pp. 116–119, 1973.
- [49] B. Noble, J. W. Daniel, et al., "Applied Linear Algebra," Prentice-Hall New Jersey, vol. 3, 1988.

Archive of SID

## **Surface Distortion Compensation in Reflector Antennas Using a Shaped Sub-Reflector**

**S. A. Hadadi, A. Ghorbani\***

Amirkabir University of Technology

(Received: 23/10/2016, Accepted: 31/01/2017)

### **Abstract**

Surface distortions on the main reflector change the radiation pattern of the reflector antenna and degrade their radiation characteristics. There are different methods to compensate the undesired effects of the main reflector's surface distortion. In the present study, it has been shown that by using a shaped sub-reflector, one can compensate the effects of the main reflector's distortions. Based on the variational mathematics, the radiation pattern has been linearized and reformulated in the matrix form. The reverse problem has been solved using the Singular Value Decomposition (SVD), and it is shown that for a dual-reflector antenna, the proposed method can be used to design a compensator shaped sub-reflector. Results show that if the amplitude of the distortion on the main reflector is less than quarter wavelength, the proposed algorithm can converge to the solution very fast.

**Keywords:** Reflector Antenna, Physical Optics Method, Surface Distortions, Compensation, Shaped Sub-Reflector.

---

\* Corresponding author E-mail: ghorbani@aut.ac.ir